

CLIPPEDIMAGE= JP355022873A
 PAT-NO: JP355022873A
 DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 55022873 A
 TITLE: MANUFACTURING METHOD OF RESIN SEALING SEMICONDUCTOR
 DEVICE

PUBN-DATE: February 18, 1980

INVENTOR-INFORMATION:

NAME
 YANO, HIDEYOSHI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME
 MITSUBISHI ELECTRIC CORP

COUNTRY
 N/A

APPL-NO: JP53096893
 APPL-DATE: August 8, 1978

INT-CL (IPC): H01L021/56; B29G003/00
 US-CL-CURRENT: 29/827, 29/827

ABSTRACT:

PURPOSE: To relieve a labor and improve a quality by restricting to a necessary and minimum limit a sealing resin protruded in performing a resin sealing process.

CONSTITUTION: A slot-like resin reservoir 6 is provided in a predetermined location on a radiation block, a slot-like resin reservoir 8 is also provided in a predetermined location on a metallic mold 7 and the size of the slots is determined depending upon the resin amount protruded. The radiation block 1, lead frame 3 and semiconductor chip 2 are set on the metallic mold 7 to be sealed by a resin 5 injection. In this case, the resin 5 is protruded to the intermediate portion between 3 the metallic block 7 and radiation block 1 or the metallic mold 7 and lead frame is introduced to the reservoirs 6 and 8 to block the resin protruded to the lead frame or radiation block. Therefore, a removing work of the resin protruded can be eliminated without reducing a

radiation effect.

COPYRIGHT: (C)1980,JPO&Japio

⑨ 日本国特許庁 (JP)

⑩ 特許出願公開

⑪ 公開特許公報 (A)

昭55-22873

5) Int. Cl.³

識別記号

庁内整理番号

⑬ 公開 昭和55年(1980)2月18日

H 01 L 21/56

7738-5 F

B 29 C 3/00

6704 4 F

発明の数 1

審査請求 未請求

(全 2 頁)

⑭ 樹脂封止型半導体装置の製造方法

機株式会社北伊丹製作所内

⑯ 特 願 昭53-96893

出 願 人 三菱電機株式会社

⑰ 出 願 昭53(1978)8月8日

東京都千代田区丸の内2丁目2

⑱ 発 明 者 矢野栄喜

番3号

⑲ 代 理 人 弁理士 葛野信一 外1名

伊丹市瑞原4丁目1番地三菱電

明 細 書

1. 発明の名称

樹脂封止型半導体装置の製造方法

2. 特許請求の範囲

トランスファモールド用の金型内に、放熱ブロック上にろう着された半導体ベレット、この半導体ベレットにワイヤ細線が配線されたリードフレームをセットし、トランスファモールド法により前記金型内に封止用樹脂を注入して樹脂封止する樹脂封止型半導体装置の製造方法において、前記放熱ブロックの一面またはこれと接合する金型の内面の少なくとも一方の面および前記リードフレームと接合する前記金型の内面の所定箇所に樹脂たまりを形成しておき、樹脂封止の際前記放熱ブロック上およびリードフレーム上への封止用樹脂のはみ出しを防止することを特徴とする樹脂封止型半導体装置の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

この発明は、樹脂封止型半導体装置の製造方法に関するものである。

従来、放熱ブロック上に固定された半導体チップとリードフレームとの間をリード細線により配線された半導体素子を金型内にセットし、トランスファモールド法により樹脂封止する樹脂封止型半導体装置の製造方法においては、樹脂封止の際、金型と放熱ブロックとの間、および金型とリードフレームとの間において封止用樹脂がはみ出してしまい、このため、放熱ブロックの放熱効果の低下の原因となり、また、リードフレームの露出部分はヘンダまたはスズメツギを施すため、これらはみ出した封止用樹脂は樹脂封止後取り除く必要があり、このため多大の労力を要していた。

この発明は上述の点にかんがみ込まれたもので、樹脂封止の際にはみ出す封止用樹脂を必要最小限に押え、品質の向上をはかるとともに労力の軽減をはかつたものである。以下この発明について説明する。

第1図はこの発明の一実施例を示す断面図で、1は放熱ブロック、2は前記放熱ブロック1上にろう着された半導体チップ、3はリードフレーム、

4は前記半導体チップ2とリードフレーム3との間に配線されたリード脚線、5は樹脂封止される封止用樹脂、6は前記放熱ブロック1上の所定箇所に溝状に形成された樹脂たまり、7はトランスファモールド用の金型、8はこの金型7の所定箇所に溝状に形成された樹脂たまりであり、これら樹脂たまり6、8はそれぞれはみ出す樹脂の量に応じて所望の大きさに形成される。

このような樹脂封止型半導体装置を形成するには、放熱ブロック1、半導体チップ2、リードフレーム3等を金型7内にセットし、トランスファモールド法により金型7内に封止用樹脂5を注入し樹脂封止する。この際、封止用樹脂5は金型7と放熱ブロック1との間および金型7とリードフレーム3との間にはみ出してくるが、はみ出した樹脂は樹脂たまり6、8にそれぞれ入り、他へはみ出すことはない。このようにして形成された樹脂封止型半導体装置を第2図(a)、(b)に示す。

なお、上記実施例では放熱ブロック1の面一方の樹脂たまり6を形成したが、これは金型7の

(3)

型、8は放熱ブロックに設けた樹脂たまりである。なお、図中の同一符号は同一または相当部分を示す。

代理人 葛 野 信 一 (外1名)

特開昭55-22873(2)

方に形成してもよく、場合によっては両方に形成することもできる。

以上説明したようにこの^(によれ)発明は、樹脂封止の際金型と放熱ブロックとの間および金型とリードフレームとの間にはみ出してくる樹脂は所要箇所へ設けた樹脂たまりに収容されることになり、従って、放熱ブロック上あるいはリードフレーム上への樹脂のはみ出しを防止できるので、放熱効果を低下させることなく、かつ労力の軽減化をはかることができる利点がある。

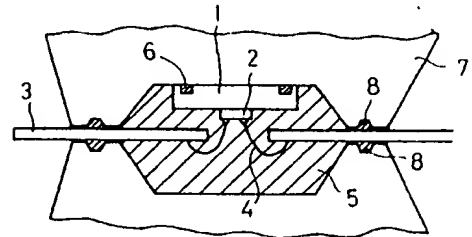
4. 図面の簡単な説明

第1図はこの発明の一実施例を示す樹脂封止型半導体装置の樹脂封止を説明するための断面図、第2図(a)、(b)はこの発明により形成された樹脂封止型半導体装置の斜視図およびA-A断面図である。

図中、1は放熱ブロック、2は半導体チップ、3はリードフレーム、4はリード脚線、5は封止用樹脂、6はトランスファモールドの金型に設けた樹脂たまり、7はトランスファモールド用の金

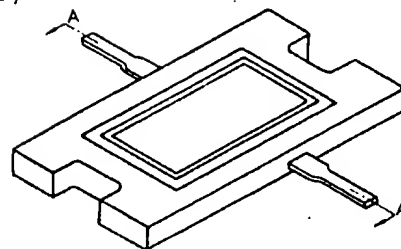
(4)

第 1 図

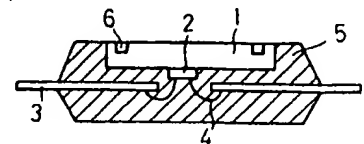


第 2 図

(a)



(b)



(5)